科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 30 年 6 月 18 日現在

機関番号: 12102

研究種目: 基盤研究(B)(一般)

研究期間: 2015~2017

課題番号: 15H03966

研究課題名(和文)人工磁壁における非線形電気磁気効果の観測

研究課題名(英文)Nonlinear magneto-electric effect in artificial magnetic domain wall

研究代表者

柳原 英人 (YANAGIHARA, Hideto)

筑波大学・数理物質系・教授

研究者番号:50302386

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 12,900,000円

研究成果の概要(和文):電気磁気効果は,電圧印加による磁化反転を実現する方法の一つとして期待されている.本研究では磁気モーメントのらせん配列によって, $P=eij\times(Si\times Sj)$ という電気分極が発現するねじれた磁気構造に注目した.異方性主軸の異なる強磁性絶縁膜を接合するとその界面では,交換結合によって界面付近に人工的な90°磁壁が生じ,それによって電気分極の発現が期待される.また,この電気分極の方向は磁化のねじれの向きに依存するため,外部電界によって電気分極を変化させることで磁化方向の変化が期待できる.磁化容易軸の異なる強磁性絶縁体二層薄膜構造の作製およびこの構造における電気磁気効果の有無について検証した.

研究成果の概要(英文): Magneto-electric effect (ME) is phenomena coupling between the magnetic and electric properties in materials. The ME effect is one of the promising candidate to reverse the magnetization by electric field. In this research, we focus on a ME mechanism for a spiral spin structure which generates electric polarization of P eij× (Si × Sj). By combining the two insulating ferromagnetic thin films with different magnetic preferential directions, an artificial 90-degree magnetic domain wall emerges at the interface of the two films, which can be expected to generate electric polarization. Since the induced electric polarity is simply dependent on the chirality of magnetic domain wall, the magnetization can be controlled by external electric field. We fabricated a bilayer system composed of two ferromagnetic insulators with different magnetic preferential directions and verified the ME effect in the bilayer system.

研究分野: 磁性薄膜

キーワード: 非線形電気磁気効果 スピネルフェライト スピントロニクス

1. 研究開始当初の背景

マルチフェロイックス現象の1つである電 気磁気(ME)効果は,外部磁場(*H*)によって 電気分極(P)が生じ、そして反対に電場(E) によって磁化 (M) が変化する現象であり,特 定の対称性を有する磁性誘電体に見られる一 般的な物質の応答現象である. ΔP α Hやその 逆効果である $\Delta M \propto E$ のような線形 ME 効果 は、1959年にジャロシンスキーが Cr₂O₃につ いて予言して以来盛んに研究が行われてきた が、室温以上で ME 効果を発現する物質は見 つかっていない. 2005年に桂らによって示さ れた非線形 ME 効果に関する基礎理論[PRL 2005]では、i,jに位置するスピンを S_i 、 S_i 、と しi,j間の方向ベクトルを e_{ij} とすると、一般的 に $P \propto e_{ij} \times (S_i \times S_i)$ (式 1) なる電気分極が現 れる (図1参照).この非線形 ME 効果に関す る論文は、現在 1200 を越える被引用数があ り, intrinsic にこの関係を満たすスピン配列 を持つ磁性体について活発な研究が行われて いる. ただし上記条件を満たす複雑なスピン 配列は本質的に複数の交換結合の競合が必要 条件となることから、非線形 ME 効果も低温 での観測にとどまっている.

本研究では、申請者らが培ってきた高品位 かつ精密な磁性酸化物薄膜の成膜技術を駆使 することで extrinsic に $P \propto e_{ij} \times (S_i \times S_i)$ を満 たすねじれたスピン構造を実現し、非線形 ME 効果理論が単相の磁性体だけでなく複合 構造膜においても有効であることを示し, さ らに室温での非線形 ME 効果による磁化反転 が実用的なレベルであるかどうか確認しよう とするものである. 非線形 ME 効果の発現に 不可欠な要素である「ねじれたスピン構造」 は, 異方性主軸の異なる2種類の強磁性体の 接合構造を用いることで実現させる.具体的 には, 垂直磁化膜と面内磁化膜を組み合わせ, 界面で交換結合させることで生まれる一種の 人工的な 90゜磁壁を導入することとなる.こ の構造を実現するために用いられる磁性薄膜 材料には、(1)高いキュリー温度、(2)絶縁性、(3) 強い磁気異方性、そして(4)界面での強い交換 結合という4条件が求められる. これらの4 つの条件を満たす絶縁性の強磁性薄膜の組み 合わせはこれまで殆ど知られておらず(ある いは、スピントロニクスにおいて注目されて こなかったことから), extrinsic に 「ねじれた スピン構造」を実現し非線形 ME 効果を検証 する研究はほぼ未着手の状態であると考える. そこで本研究代表者は、多様な磁性を示すス ピネルフェライト群の薄膜に注目した. これ らの多くは良好な絶縁膜であるとともに高い キュリー温度を有する(上記条件(1),(2)). 垂 直磁化膜となる CoFe₂O₄ と、NiFe₂O₄ あるい は γ -Fe₂O₃ (マグヘマイト)を組み合わせるこ とで、extrinsic に「ねじれたスピン構造」を 作り出すことが可能となる.

これらのスピネルフェライトについては, 世界中で様々な手法を用いて薄膜化が試みられてきたが,バルクに比べて著しく磁化が小

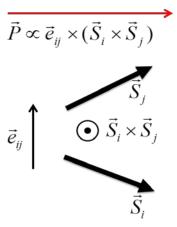


図 1 非線形電気磁気効果の発 現条件(式1)

さかったり、本来絶縁体であるはずが電気伝 導を示したりとこれまで高品位なものが得ら れていなかった. 申請者らは, 反応性マグネ トロンスパッタリング法を用いることで、バ ルクに匹敵する磁化を示す CoFe₂O₄薄膜を成 長させることが可能であること, そして MgO(001)上に成膜すると正方歪の導入に伴 い K_u~15Merg/cm³ にも達する結晶磁気異方 性を有する垂直磁化膜となることを見出した (条件(3)). また,良好な絶縁特性を室温にお いて確認している. 一方, NiFe₂O₄ や γ -Fe₂O₃ 薄膜についてはバルク並みの磁化を有し、さ らには結晶磁気異方性が小さいことから面内 磁化膜になることを確認している. また反応 性スパッタリング法により成長させたスピネ ルフェライト薄膜は原子層単位で平滑な表面 を示すことと,複合構造を構成する2つの強 磁性層は同じスピネルフェライトという物質 群に属することから CoFe₂O₄/NiFe₂O₄(001) あるいは $CoFe_2O_4/\gamma$ - Fe_2O_3 (001)界面におけ る交換結合は、バルク並みに大きなものであ ることが容易に予想される(条件(4)).

2. 研究の目的

この研究では、以下に示す 2 点の検証を目 標とした. (1)人工磁壁構造の確認とねじれ構 造の最適化:ねじれ効果を取り込んだ磁化過 程のシミュレーションを行い、界面付近での ねじれの度合いを調べる. そしてシミュレー ションの結果に基づいて, 試料設計を行い CoFe₂O₄/NiFe₂O₄ (001)および CoFe₂O₄/γ Fe₂O₃ (001)複合膜を作製する. (2)電界誘起磁 化反転の検証:磁気光学効果を用いて電界印 加に伴うスピン構造の変化の観測. (1)で開発 したシミュレーションを利用して磁化反転が 生じうる最適な膜厚を決めることで, 複合膜 の磁化を直接的に反転させることを目指した. 項目(2)を確認することで、式1に基づく非線 形 ME 効果の存在が実験的に示すことができ る.

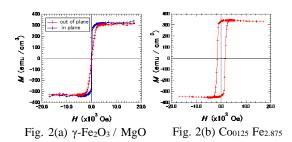
3. 研究の方法

試料は、反応性 RF マグネトロンスパッタリング法を用いた。アニール処理を行った MgO (001) 基板上に RF マグネトロンスパッタリング 法 を 用 い て , 垂 直 磁 化 膜 で ある $Co_{0.125}Fe_{2.875}O_4$ (001) (CF(1:23)-0) を約 10 nm, その後,面内磁化膜となる γ - Fe_2O_3 (GF0) を約 30 nm を成膜し、強磁性二層薄膜を作製した。そして,作製した試料に Cr + Au の電極を設け,試料に電場を約 10 - 20 kV/cm 印加した状態で、MOKE によって磁化過程の計測をした.

4. 研究成果

はじめに、強磁性絶縁体二層薄膜の材料となる γ -Fe₂O₃, Co_{0.125}Fe_{2.875}O₄ の作製と磁気特性評価を行った。RHEED 像の結果から、ストリーク状の回折線かつ菊池ラインが観測された。このことから、各薄膜試料は単結晶状態であり、平坦性の高い表面を持っていることが分かる。また、成膜後の RHEED 像は、スピネル構造に由来した基本的な回折線の間にストリーク状の回折線が確認でき、試料の最表面では長周期的な再構成が生じていることが確認された。

作製した γ-Fe₂O₃, と Co_{0.125}Fe_{2.875}O₄の面直 XRD 測定の結果を示す. この二試料の XRD 測 定結果から、MgO (004) 回折線付近に γ- Fe_2O_3 , と $Co_{0.125}Fe_{2.875}O_4$ の回折線を確認した. これは γ -Fe₂O₃ と Co_{0.125}Fe_{2.875}O₄ の(008) 回 折線に対応している. この回折線の位置から 膜面垂直方向の平均的な格子定数が求められ, それぞれの格子定数は, $a_{GFO\perp}$ = 8.25 Å, $a_{CFOL} = 8.28$ Åであった. それぞれの回折線 の位置から得られた膜面垂直方向の格子定数 は、各試料の基本格子定数に比べて小さい. したがって、作製した各試料の膜面内の結晶 格子が MgO 基板の格子定数 (4.21 ×2= 8.42 Å) によって拡張され、それに伴って膜 面垂直方向の格子定数が減少したと考えられ る. この結果はこれまでの先行研究と同様の 傾向を示している.

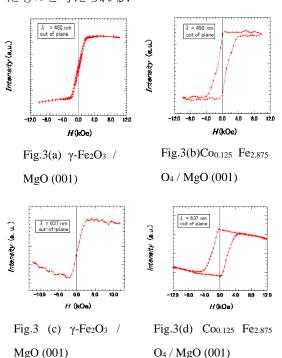


 γ -Fe₂0₃ 薄膜では, 膜面垂直・膜面内方向の磁化過程に大きな差はみられなかった. 一方, Co₀₁₂₅ Fe_{2.875} O₄ 薄膜では, 膜面垂直方向に約334 emu/cm³ の残留磁化を持っていた. また膜面内方向では, \pm 17 kOe の磁場でも磁化曲線が飽和しなかった. これらのことから, γ -Fe₂O₃ 薄膜は, ほぼ等方的な磁気異方性を有するのに対して, Co₀₁₂₅ Fe_{2.875} O₄ 薄膜は膜面垂直方向への磁気異方性を有していることがわかった.

つづいて, γ-Fe₂O₃, Co_{0.125} Fe_{2.875} O₄ の磁気 トルク測定をおこなった. その結果各試料の 磁気異方性エネルギーは.

 K_u^{eff} $(\gamma - Fe_2O_3) - 0.24$ Merg/cm³, K_u^{eff} $(\nabla - Fe_2O_3) - 0.24$ Merg/cm³ , K_u^{eff} $(Co_{0.125}Fe_{2.875}O_4) = 1.62$ Merg/cm³ となり,磁化測定の結果と比べて矛盾はない。また,求めた各試料の磁気異方性エネルギーの大きさは, $\gamma - Fe_2O_3$ の正方晶化に伴った磁気双極子エネルギーと形状磁気異方性エネルギーから生じる実効的な磁気異方性エネルギーの先行研究と同程度であった。 $Co_xFe_{3-x}O_4$ の磁気異方性エネルギーについても以前の報告と同程度であった。

つづいて, MOKE を用いた各試料の磁化過程 について考察する. γ-Fe₂O₃, Co_{0.125}Fe_{2.875}O₄ の MOKE 測定結果を示す. MOKE 測定に使用す るプローブ光波長 λ は約 450 nm, 637 nm の 二種類をもちいた. 測定には光学遅延変調法 を用いており、各試料について Kerr 回転角お よび、カー楕円率の測定を行ない、高感度の 測定法を選択した. 各試料の VSM 測定と MOKE 測定から得られた磁化過程の結果を比較する と,二つの磁化過程は類似している.しかし, Fig. 3 (c), (d) に示すように、波長 λ = 637 nm のプローブ光を用いて測定した MOKE による磁化過程評価では、全体的に右下 がりの成分が確認できた. この現象は、MOKE 装置内における対物レンズ内のファラデー効 果に起因するものであると考えられる. 今回 使用した対物レンズの作動距離 WD は約13 mm であり、測定試料とレンズとの距離が非常 に近い. したがって、測定中に電磁石側から 漏れる磁束が対物レンズ内を通ることでレン ズ内にファラデー効果を生じさせる. これに よって線形的な成分が計測結果に寄与してき たものと考えられる.



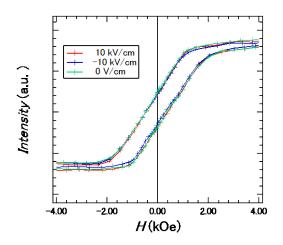


Fig. 4 γ-Fe₂O₃ (30nm) / Co_{0.125}Fe_{2.875}O₄ (10 nm) /MgO (001) (円二色性).

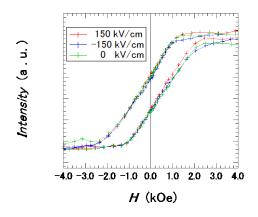


Fig. 5 γ -Fe₂O₃ (30nm) / Co_{0.125}Fe_{2.875}O₄ (10 nm) /MgO (001) (力一回転).

ME 効果の測定には磁気光学効果を用いて評価した.まず、Figs. 4、5 に γ -Fe $_2$ O $_3$ (30nm) / Co $_{0.125}$ Fe $_{2.875}$ O $_4$ (10 nm) /MgO (001) の縦カー効果測定における円二色性、カー回転の結果を示す.

Figs. 4,5 の計測結果から、電界の有無や極 性によって磁化過程に有意な差は生じなかっ た. また, 二つの異なる計測手法によって得 られた磁化過程は、どちらも極カー効果測定 (入射角度 $\theta = 0^{\circ}$) 結果と非常に類似する結 果が得られた. このことから, 得られた磁気 カー効果は、垂直磁化膜 (Co_{0.125} Fe_{2.875} O₄ 薄 膜) の膜厚増加にともなった膜面垂直方向の 磁気モーメントが支配的であると考えられる. 今回もちいた縦カー効果測定の配置では、プ ローブ光は約30°の角度をもって斜め入射さ れ、これによって検出される信号は極カー効 果成分と縦カー効果成分の和となる. したが って, 本実験の試料では, 垂直磁化膜 (Co_{0,125} Fe2.875 O4 薄膜) の膜厚が十分に厚く,極カー 効果成分が測定結果に大きく寄与したと考え られる. 今後は薄膜化した試料の計測が必要 である.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

〔雑誌論文〕(計2件)

"Spin Hall magnetoresistance at the interface between platinum and cobalt ferrite thin films with large magnetic anisotropy", Takeshi Tainosho, Tomohiko Niizeki, Jun-ichiro Inoue, Sonia Sharmin, <u>Eiji Kit</u>a, and <u>Hideto Yanagihara</u>, AIP ADVANCES 7, 055936 (2017).

"RHEED oscillations in spinel ferrite epitaxial films grown by conventional planar magnetron sputtering", T. Ojima, T. Tainosho, S. Sharmin, and <u>H. Yanagihara</u>, AIP Advances 8, 045106 (2018).

[学会発表](計3件)

日本物理学会 2016 年秋季大会 13pPSA-4「絶縁強磁性二層薄膜における非線形電気磁気効果の観察」, 江口徹, 松本光玄, 田結荘健, 小野田浩成, Sonia sharmin, <u>喜多英治</u>, <u>柳原英</u>人, 2016 年 9 月 13 日.

日本物理学会 第 72 回年次大会 17aS-PS-1 「絶縁強磁性二層薄膜における非線形電気磁 気効果の観察 II」, 江口徹, 松本光玄, 婁庚健, 石橋隆幸, <u>柳原英人</u>, 2017年3月17日.

日本物理学会 2017 年秋季大会 21aPS-99「絶 縁強磁性二層薄膜における非線形電気磁気効 果の観察 III」, 江口徹, 石橋隆幸, <u>柳原英人</u>, 2017 年 9 月 21 日.

[図書] (計0件)

[産業財産権]

- ○出願状況(計0件)
- ○取得状況(計0件)
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

柳原 英人 (YANAGIHARA HIDETO) 筑波大学数理物質系・教授 研究者番号:50302386

(3)連携研究者

喜多英治 (KITA EIJI) 筑波大学数理物質系・特任教授 研究者番号:80134203